









	<b>STB21NM60N-1</b>	
	제조업체 부품 번호:	STB21NM60N-1
제조업체 / 브랜드:	N/A	
설명서 일부:	MOSFET N-CH 600V 17A I2PAK	
RoHS 상태:	무연 / RoHS 준수	
재고 상태:	New original, 5205 pcs Stock Available.	
에서 운송된다:	Hong Kong	
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

명세서

제품 모델	STB21NM60N-1
제조사	N/A
기술	MOSFET N-CH 600V 17A I2PAK
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	5205 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	4V @ 250μA
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	I2PAK
연속	MDmesh™
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	220 mOhm @ 8.5A, 10V
전력 소비 (최대)	140W (Tc)
포장	Tube
패키지 / 케이스	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
작동 온도	150°C (TJ)
실장 형	Through Hole
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	1900pF @ 50V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	66nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	600V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	17A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p><b>STB21NM50ND</b> ST ST SOT263</p>	 <p><b>STB21NM50N-1</b> N/A MOSFET N-CH 500V 18A I2PAK</p>	 <p><b>STB21NM60ND</b> N/A MOSFET N-CH 600V 17A D2PAK</p>	 <p><b>STB21NM60ND MOS</b> ST ST D2-PAK</p>
 <p><b>STB21NM50N</b> N/A MOSFET N-CH 500V 18A D2PAK</p>	 <p><b>STB21NM50N B21NM50N</b> ST ST TO-263</p>	 <p><b>STB22N95K5 22N95K5</b> ST ST TO-263</p>	 <p><b>STB21NM60N</b> N/A MOSFET N-CH 600V 17A D2PAK</p>

STB21NM60N-1 관련 키워드

더

STB21NM60N-1	STB21NM60N-1 데이터 시트	STB21NM60N-1 데이터 시트	STB21NM60N-1 PDF	STB21NM60N-1
STB21NM60N-1 전자	STB21NM60N-1 부품	STB21NM60N-1 유통 업체	STB21NM60N-1 이미지	STB21NM60N-1 부품
STB21NM60N-1 가격	STB21NM60N-1 제조업체	STB21NM60N-1 사진	STB21NM60N-1 재고	STB21NM60N-1 인벤토리
STB21NM60N-1 새로운	STB21NM60N-1 원본	STB21NM60N-1 보증	STB21NM60N-1 RFQ	STB21NM60N-1 온라인 주문

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2024 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited